

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 23.09.2022 14:27:38
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю:

Руководитель ООП



Б.Б.Педько

«28»

июня

2022 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Физика нано- и гетероструктур

Направление подготовки

03.03.03 Радиофизика

профиль

Физика и технология радиоэлектронных приборов и устройств

Для студентов

3 курса, очной формы обучения

Составитель: к.ф.-м.н. Третьяков С.А.

Тверь, 2022

I. Аннотация

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

Физика нано- и гетероструктур

2. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является: усвоении современных представлений о физических процессах и технологиях, лежащих в основе создания субмикронных структур гетеро- и наноэлектроники, в том числе современных представлений о физических, химических и биологических свойствах различных наноматериалов, а также о возможности использования нанообъектов в перспективных областях промышленности.

Задачами освоения дисциплины являются: получение сведений о классификации наноструктур; ознакомление со способами получения наноструктур и гетероструктур; определение областей техники, в которых наноструктуры набирают популярность; умение ориентироваться в современной научно-технической литературе, связанной с физикой гетеро и нано структур.

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана.

4. Объем дисциплины

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе

контактная работа: лекции 30 часов, лабораторные работы 30 часов; **самостоятельная работа:** 48 часов.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-2 способность самостоятельно приобретать новые знания, используя	Владеть: навыками поиска информации в сети Интернет Уметь: самостоятельно приобретать знания, используя современное оборудование и информационные технологии

современные образовательные информационные технологии	
ПК-1 способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования	<p>Владеть: технологией получения эпитаксиальных слоев, сверхрешеток и наноструктур, гетероструктур для твердотельной электроники.</p> <p>Уметь: планировать проведение современного физического эксперимента в области физики конденсированного состояния с целью создания гетероструктур различного типа;</p> <p>Знать: классификацию наноструктур; принципы процессов и методов получения эпитаксиальных слоев, сверхрешеток и наноструктур, гетероструктур для твердотельной электроники, физические и химические методы осаждения и распыления пленок, интердиффузия и реакции в пленках, их механические свойства и параметры их характеристики, особенности формирования металлических и защитных покрытий.</p>

6. Форма промежуточной аттестации

зачет в 6 семестре

7. Язык преподавания русский.

II. Структура дисциплины

1. Структура дисциплины для студентов очной формы обучения

Учебная программа – наименование тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)		Самостоятельная работа (час.)
		Лекции	Лабораторные работы	
<p>1 Классификация нанообъектов Наноструктурированные материалы и наночастицы. Классификация В. Оствальда по агрегатному состоянию фаз. Классификация по размерам. Классификация по мерности. Классификация Г. Глейтера основных типов структур неполимерных наноматериалов по химическому составу, распределению фаз и форме. Наноматериалы: функциональные, интеллектуальные, нанообъекты, содер-</p>	4	2		2

<p>жащие специфические группы атомов, молекул нанометровых размеров (до 100 нм). Функциональные наноматериалы: низкоразмерные объекты; тонкие слои, пленки; нанопроволоки, полимерные наноматериалы. Интеллектуальные наноматериалы: объемные, полимерные и биоматериалы.</p>				
<p>2 Относительная роль физических и химических связей и взаимодействий применительно к нанобъектам</p> <p>Относительная роль гравитационных, электростатических, электродинамических и магнитных взаимодействий на наноуровне. Природа сил притяжения и отталкивания. Когезионная энергия твердых тел. Природа межмолекулярных взаимодействий Ориентационное, индукционное и дисперсионные взаимодействия. Природа водородной связи и ее особенности</p>	6	4		2
<p>3 Особые физические и химические свойства наночастиц и наноструктурированных материалов. Зависимость свойств от размера частиц</p> <p>Особые свойства нанобъектов, обусловленные соизмеримостью их размеров и характерной длиной физических свойств Особые свойства нанобъектов, обусловленные огромной поверхностной энергии: доля поверхности в наноматериалах, величина поверхностной энергии в наноматериалах. Поверхности и геометрические размеры кристаллов. Поверхность и геометрические размеры нанобъектов.</p>	8	4		4
<p>4. Идеальная и реальная кристаллические структуры наноразмерных материалов</p> <p>Структурные и электронные магические числа. Зависимость периода решетки от размеров наноматериала.</p>	8	4		4

Дефекты кристаллической решетки наноматериалов. Точечные дефекты в наночастицах. Линейные дефекты в наноматериалах. Микроискажения кристаллической решетки.				
5. Физико-химические основы формирования наноструктурированных материалов Формирования наноструктур по механизму «снизу – вверх» Термодинамические аспекты гомогенного зародышеобразования. Расчет критического размера и изменения свободной энергии зародышей разной формы. Термодинамические аспекты гетерогенного зародышеобразования на поверхности кристалла. Кинетика гетерогенного зародышеобразования Формирования наноструктур по механизму «сверху – вниз».	8	4		4
6. Физико-химические основы планарной технологии. Основные операции планарной технологии. Технологические маршруты производства различных типов интегральных схем. «Критические» операции, определяющие минимальные размеры элементов. Переход с наноразмерным элементам.	8	4		4
7. Авто-и гетероэпитаксия Механизмы эпитаксиального роста тонких пленок. Автоэпитаксия кремния. Эпитаксия из газовой фазы. Молекулярнолучевая эпитаксия. Формирование наноразмерных структур. Гетероэпитаксия. Получения структур «кремний-на-диэлектрике».	4	2		2
8. Процессы металлизации интегральных схем. Процессы формирования межсоединений и их вклад в быстродействие интегральных схем. Требования к материалам для межсоединений. Физические и химические методы	4	2		2

получения тонких пленок. Удельное сопротивление, контактное сопротивление различных материалов, применяемых в кремниевой технологии. Химическая и физическая адгезия. Эффект электромиграции. Стойкость к электромиграции. Недостатки алюминиевой металлизации. Силициды тугоплавких металлов. Системы металлизации на основе меди. Многоуровневая металлизация				
9. Сканирующая атомно-силовая микроскопия Силовое взаимодействие между зондом и поверхностью. Датчик силового взаимодействия – кантеливер. Задача Герца. Силы Ван-Дер-Ваальса. Энергия ориентационного взаимодействия. Энергия индукционного взаимодействия. Энергия дисперсионного взаимодействия. Влияние консервативных сил на решение задачи Герца. Методы атомно-силовой микроскопии. Формирование изображения в атомно-силовой микроскопии.	4	2		2
10. Сканирующая туннельная микроскопия Туннельный эффект. Распределение электронов в приграничной области твердого тела. Потенциальный барьер. Плотность туннельного тока между зондом и образцом. Разрешающая способность туннельного микроскопа. Режимы работы сканирующего туннельного микроскопа	4	2		2
<i>Лабораторные работы</i>				
Оценка влияния размеров центров кристаллизации, на дальнейшее процесс формирования структур.	10		6	4
Изучение ростового оборудования, используемого для получения гетероструктур.	10		6	4
Исследование наноструктур с помощью РЭМ	10		6	4

Исследование поверхности гетероструктур методом оптической профилометрии	10		6	4
Формирования нанокластеров в коллоидных растворах.	10		6	4
ИТОГО	108	30	30	48

III. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

- планы лабораторных занятий,
- методические рекомендации
- требования к рейтинг контролю
- итоговый контроль

IV. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Форма проведения промежуточного контроля: студенты, освоившие программу курса «Физика нано- и гетероструктур» могут получить зачет по итогам семестровой и полусеместровой рейтинговой аттестации согласно «Положения о рейтинговой системе обучения и оценки качества учебной работы студентов ТвГУ» (протокол №4 от 25 октября 2017 г.). Максимальная сумма баллов, которые можно получить за семестр 100.

Если условия «Положения о рейтинговой системе ...» не выполнены, то зачет сдается согласно «Положения о промежуточной аттестации (экзаменах и зачетах) студентов ТвГУ» (протокол №4 от 25 октября 2017 г.).

Контроль сформированности компетенции осуществляется с помощью оценочных средств на основе критериев, которые разрабатываются с целью выявления соответствия этапов освоения компетенции планируемым результатам обучения (см. карту компетенций).

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции ОПК-2 "Способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные образовательные информационные технологии "

Этап формирования компетенции, в котором участвует дисциплина	Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков (2-3 примера)	Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания
Владеть: навыками поиска информации в сети Интернет	Сделать доклад на тему "Особые свойства нанообъектов".	<ul style="list-style-type: none"> • Тема актуальна и сформулирована грамотно – 1 балл; • тема полностью раск-

	<p>Сделать доклад на тему "Физические и химические методы получения тонких пленок".</p>	<p>рыта в докладе; корректно использован понятийный аппарат; логичность и ясность изложения – 2 балла;</p> <ul style="list-style-type: none"> • использованы публикации последних лет – 1 балл; • определена позиция автора; предложен и аргументирован собственный взгляд на проблему – 1 балл;
<p>Уметь: самостоятельно приобретать знания, используя современное оборудование и информационные технологии</p>	<p>Режимы работы сканирующего туннельного микроскопа</p> <p>Исследование наноструктур с помощью РЭМ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 4 балла • Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл • Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов • Факты и примеры в полном объеме обосновывают выводы – 3 балла • Допущена фактическая ошибка, не приведшая к существенному искажению смысла – 2 балла • Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 0 баллов

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции ПК-1 "Способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования"

Этап формирования компетенции, в котором участвует дисциплина	Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков (2-3 примера)	Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания
<p>Владеть: технологией получения эпитаксиальных слоев, сверхрешеток и наноструктур, гетероструктур для твердотельной электроники.</p>	<p>Современное ростовое оборудование для получения гетероструктур.</p> <p>Механизмы формирования наноструктур, их принципиальное различие.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема актуальна и сформулирована грамотно – 1 балл; • тема полностью раскрыта в докладе; корректно использован понятийный аппарат; логичность и ясность изложения – 2 балла; • использованы публикации последних лет – 1 балл; • определена позиция автора; предложен и аргументирован собственный взгляд на проблему – 1 балл;
<p>Уметь: - планировать проведение современного физического эксперимента в области физики конденсированного состояния с целью создания гетероструктур различного типа</p>	<p>Как формируются нанокластеры в коллоидных растворах.</p> <p>Влияние консервативных сил на решение задачи Герца.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 4 балла • Аргументация на теоретическом уровне неполная, смысл ряда ключевых понятий не объяснен – 1 балл • Терминологический аппарат непосредственно не связан с раскрываемой темой – 0 баллов • Факты и примеры в полном объеме обосновывают выводы – 3 балла • Допущена фактическая

		<p>ошибка, не приведшая к существенному искажению смысла – 2 балла</p> <ul style="list-style-type: none"> • Допущены фактические и логические ошибки, свидетельствующие о непонимании темы – 0 баллов
<p>Знать: классификацию наноструктур; принципы процессов и методов получения эпитаксиальных слоев, сверхрешеток и наноструктур, гетероструктур для твердотельной электроники, физические и химические методы осаждения и распыления пленок, интердиффузия и реакции в пленках, их механические свойства и параметры их характеристики, особенности формирования металлических и защитных покрытий.</p>	<p>Особые физические, химические и биологические свойства нанообъектов и наноструктурированных систем.</p> <p>Относительная роль гравитационных, электростатических, электродинамических и магнитных взаимодействий на наноуровне.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Тема раскрыта с опорой на соответствующие понятия и теоретические положения – 4 балла • Факты и примеры в полном объеме обосновывают выводы – 4 балла • Ответ характеризуется композиционной цельностью, соблюдена логическая последовательность – 3 балла

V. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная литература:

1. Троян П.Е. Нанoeлектроника [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. — 88 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/13949.html>
2. Орлова М.Н. Нанoeлектроника [Электронный ресурс]: курс лекций / М.Н. Орлова, И.В. Борзых. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2013. — 50 с. — 978-5-87623-725-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/56246.html>

б) дополнительная литература

1. Драгунов В.П. Микро- и нанoeлектроника [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Драгунов, Д.И. Остертак. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск:

Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 38 с. — 978-5-7782-2095-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45107.html>

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

VII. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

План лабораторных работ

1. Оценка влияния размеров центров кристаллизации, на дальнейшее процесс формирования структур.
2. Изучение ростового оборудования, используемого для получения гетероструктур.
3. Исследование наноструктур с помощью РЭМ
4. Исследование поверхности гетероструктур методом оптической профилометрии
5. Формирования нанокластеров в коллоидных растворах.

Методические рекомендации

Предметом оценки является подготовка студентов к занятиям, работа студентов на лабораторных занятиях.

Оценки успеваемости студентов проходит в модульную неделю в соответствии с графиков учебного процесса.

Практические задания по демонстрации компетенций заключаются в устных или письменных ответах на поставленные преподавателем или составленным самими студентами вопросы (традиционные или в форме тестов). При этом оценивается обоснованность ответа, ясность и последовательность изложения мысли. Такая демонстрация компетенций проверяет уровень владения теоретическим и практическим материалом.

Требования к рейтинг-контролю

Оценка знаний студентов осуществляется по результатам успеваемости и оценивается по 100 – бальной системе. Семестр делится на два модуля.

Дисциплина «Технологические аспекты преобразования энергии» заканчивается зачетом в 8 семестре. Согласно нормативно – методическим материалам рейтинговой системы оценки качества учебной работы студентов ТвГУ, студент по предмету для получения зачета должен набрать за семестр не менее 50 баллов. Учащиеся, набравшие менее 20 баллов получают теоретический зачет в конце семестра.

1 контрольная точка. По текущей работе студента – 21 баллов. Итоговый контроль за модуль – 9 баллов. Всего 30 баллов.

2 контрольная точка. По текущей работе студента – 21 баллов. Итоговый контроль за модуль – 9 баллов. Премияльные за выполнение и сдачу всех лабораторных работ 20 баллов. Выступление с докладом – 20 баллов. Всего 70 баллов.

Баллы по текущей работе студента начисляются за следующие виды работ:

- лабораторные работы – 7 баллов;
- выступление с докладом – 20 баллов;
- модульная контрольная работа – максимум 9 баллов.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена, который включает письменные или устные ответы на теоретические вопросы.

Вопросы к зачету

Основные тенденции развития микро-и нанотехнологий создания устройств электронной техники.

- Закон Мура. Основные причины замедления темпов роста степени интеграции.
- Квантовые ограничения для приборов классической электроники.
- Физические ограничения минимальных размеров ИС.
- Схемотехнические и технологические ограничения минимальных размеров ИС.
- Базовые операции и основные принципы планарной технологии. Изменения набора базовых операций при переходе к наноразмерным приборам.
- Бездислокационный кремний. Геттерирование примесей. Внутреннее и внешнее геттерирование.
- Термическое окисление. Основные методы. Получение сверхтонких слоев.
- Анизотропия ионного легирования. Температурные режимы. Применения ионного легирования в технологии субмикронных СБИС.
- Автоэпитаксия кремния. Методы автоэпитаксии.
- Молекулярно-лучевая эпитаксия в технологии наноразмерных структур электроники.
- Основные требования к подложкам в процессах гетероэпитаксии.
- Эпитаксия соединений АЗБ5. Мос-гидридная эпитаксия.
- Предельная разрешающая способность различных методов литографии.
- Оптическая литография в дальнем УФ-диапазоне.
- Рентгенолитография.
- Электронно-лучевая литография. Эффект близости.
- Электронно-проекторная литография.
- Ионная литография.
- Основные требования к материалам для межсоединений. Многоуровневые системы металлизации.

- Сравнительная характеристика алюминиевой и медной систем металлизации.
- Виды классификации нанообъектов. Определение дисперсности. Характеристики дисперсности наноматериалов. Классификация по мерности.
- Наноструктурные материалы. Функциональные и интеллектуальные наноматериалы. Приведите примеры их использования.
- Особые физические, химические и биологические свойства нанообъектов и наноструктурированных систем. Размерные эффекты.
- Относительная роль гравитационных, электростатических, электродинамических и магнитных взаимодействий на наноуровне. Природа сил притяжения и отталкивания.
- Поверхности и геометрические размеры кристаллов и других нанообъектов
- Идеальная кристаллические структуры наноразмерных материалов. Структурные и электронные магические числа. Зависимость периода решетки от размеров наноматериала.
- Реальная кристаллическая структура наноструктурированных материалов. Дефекты кристаллической решетки, характерные для наноматериалов. Возможность существования вакансий и дислокаций в наноматериалах.
- Микроискажения кристаллической решетки в наноматериалах.
- Поверхность, границы, морфология наноматериалов. Доля поверхности в наноматериалах.
- Величина поверхностной энергии. Поверхностный потенциал Гиббса.
- Границы зерен в наноструктурных материалах. Морфология наночастиц.
- Механизмы формирования наноструктур, их принципиальное различие. Гомогенное зародышеобразование наночастиц. Энергия Гиббса конкретных процессов получения наноматериалов и для зародышей разной формы.
- Гетерогенного зародышеобразования наночастиц на поверхности кристалла и в реакциях восстановления.
- Особенности формирования наноструктуры по механизму «сверху-вниз»
- Квазиравновесие в наносистемах; устойчивость нанообъектов. Изменение фазовых равновесий в наноразмерных системах. Уравнение Лапласа.
- Фазовое равновесие в наносистемах. Изменение температуры плавления в наноматериалах. Уравнение Томсона. Модели, описывающие понижение температуры плавления наносистем.
- Особенности полиморфных превращений в наносистемах. Устойчивость нанообъектов. Образование твердых растворов.
- Квантоворазмерные эффекты в металлах, полупроводниках и молекулярных кристаллах.
- Особенности зонной структуры металлов, полупроводников в нанокристаллическом состоянии.

- Эффекты, обусловленные размерами и размерностью нанообъектов: размерные эффекты. Задача о частице в потенциальном ящике. Частичная локализация. Поведение электронов в тонкой пленке.
- Квантовое ограничение. Квантовая яма. Квантовая проволока. Квантовая точка.
- Размерность объекта и электроны проводимости. Ферми-газ и плотность состояний. Свойства, зависящие от плотности состояний. Условия, при которых наблюдаются квантовые эффекты.
- Оптические свойства полупроводников. Спектры поглощения и люминесценции, их связь с зонной структурой полупроводников. Оценка размеров наночастиц по спектральным данным.
- Методы синтеза разупорядоченных твердотельных структур. Влияния наномасштабности зерен на объемную структуру и свойства разупорядоченных твердотельных материалов
- Линейные дефекты: трещины и дислокации в разупорядоченных композиционных материалах. Определение дислокации и вектора Бюргерса. - Особенности и свойства дислокации. Различие величин модулей упругости и пределов прочности: наноструктурированного материала и объемного материала с микронным размером зерна.

VIII. Перечень педагогических и информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (по необходимости)

Процесс обучения включает аудиторные занятия путем проведения лекционных и семинарских занятий, групповые и индивидуальные консультации, текущий контроль полученных знаний, использование различных форм научно-исследовательской деятельности студентов, самостоятельную работу, а так же проведение итогового контроля.

IX. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных* помещений	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Учебная аудитория № 28 (170002 Тверская обл., г. Тверь, Садовый пер., д. 35)	1. Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 2. Экран настенный 153x203 3. Переносной комплект	Adobe Acrobat Reader DC – бесплатно Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017

	мультимедийной техники.	Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. Google Chrome – бесплатно MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017
--	-------------------------	--

Помещения для самостоятельной работы:

Наименование помещений	Оснащенность помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
<p>Помещение для самостоятельной работы, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, практики, Компьютерный класс физико-технического факультета. Компьютерная лаборатория робототехнических систем №4а (170002 Тверская обл., г. Тверь, Садовый пер., д. 35)</p>	<p>1. Компьютер RAMEC STORM C2D 4600/160Gb/ 256mB/DVD-RW +Монитор LG TFT 17" L1753S-SF – 12 шт 2. Мультимедийный комплект учебного класса (вариант № 2) Проектор Casio XJ-M140, настенный проекц. экран Lumien 180*180. ноутбук Dell N4050. сумка 15,6", мышь 3. Коммутатор D-Link 10/100/1000mbps 16-port DGS-1016D 4. Видеокамера IP-FALCON EYE FE-IPC-BL200P, ОнЛайн Трейд ООО 5. Видеокамера IP-FALCON EYE FE-IPC-BL200P, ОнЛайн Трейд ООО 6. Демонстрационное оборудование комплект «LegoMidstormsEV3» 7. Комплект учебной мебели</p>	<p>Adobe Acrobat Reader DC - бесплатно Cadence SPB/OrCAD 16.6 - Государственный контракт на поставку лицензионных программных продуктов 103 - ГК/09 от 15.06.2009 Google Chrome - бесплатно Java SE Development Kit 8 Update 45 (64-bit) - бесплатно Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 октября 2016 г. Lazarus 1.4.0 - бесплатно Lego MINDSTORM EV3 - бесплатно Mathcad 15 M010 - Акт предоставления прав ИС00000027 от 16.09.2011 MATLAB R2012b - Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012 Microsoft Express Studio 4 - бесплатно MiKTeX 2.9 - бесплатно MPICH 64-bit – бесплатно MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK - бесплатно Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017</p>

Х. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Дата и протокол заседания кафедры, утвердившего изменения
1.	Раздел IV	Реквизиты «Положения о рейтинговой системе обучения и оценки качества учебной работы студентов ТвГУ» и «Положения о промежуточной аттестации (экзаменах и зачетах) студентов ТвГУ»	Протокол Совета ФТФ №5 от 31 октября 2017 г.
2.	Раздел IX	Оснащенность аудиторного фонда для проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов согласно «Справки МТО ООП ...»	Протокол Совета ФТФ №5 от 31 октября 2017 г